Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung							
2	Der Silizium-Germanium-Heterobipolartransistor							
	2.1	Grund	lagen des SiGe-HBTs	5				
	2.2	Besch	reibung des ATMEL-SiGe1-Prozesses	9				
	2.3	Model	lieren der SiGe-Heterobipolartransistoren	11				
3	Kon	Konzentrierte passive Strukturen						
3.1		Kapazitäten auf dem ATMEL-Prozess						
	3.2	Spuler	und Koppler	16				
		3.2.1	Spulen auf dem ATMEL-Prozess	17				
		3.2.2	Gekoppelte Spulen im ATMEL-Prozess	21				
		3.2.3	Spulen auf dielektrischen Schichten	25				
4	Vert	Verteilte passive Strukturen						
4.1 Hochfrequenzleitungen		Hochf	requenzleitungen	29				
		4.1.1	Koplanarleitungen	31				
		4.1.2	Mikrostreifenleitungen	34				
		4.1.3	Triplate-Leitungen	37				
4.2 Antennen auf Waferebene				40				
		4.2.1	Patchantennen	41				
		4.2.2	Schlitzantennen	44				
		4.2.3	Schleifenantennen	47				

5	Oszillatoren						
	5.1	.1 Einführung		50			
	5.2	Grundlagen des Oszillatorentwurfes					
	5.3	5.3 Entwurf eines differentiellen Oszillators					
		5.3.1	Messungen und Simulationen des 24 GHz-Oszillators	57			
		5.3.2	24 GHz-Oszillator mit Puffer-Verstärker	60			
		5.3.3	Realisierter 32 GHz-Oszillator mit und ohne Puffer-Verstärker	62			
6	Inte	Integrationstechnologien					
	6.1	Zwisch	henebenenisolatoren und Membranen auf Polymerbasis	66			
		6.1.1	Grundlagen und Eigenschaften von BCB	67			
		6.1.2	Bearbeitung von photosensitivem BCB	71			
	6.2	2 Siliziumätzen					
	6.3	Integra	ationstechnologie für Schleifenantennen	78			
	6.4	Integra	ationstechnologie für Patchantennen	82			
	6.5	Übergang vom integrierten Schaltkreis zum Substrat					
	6.6	Bestim	nmung der abgestrahlten Leistung	86			
7	Aufl	Aufbauten mit den Modulen mit BCB-Membrane					
	7.1	Stabili	tät und Zuverlässigkeit der Membranen	89			
	7.2	Verkap	oselung der Module mit Membranen	90			
Zι	ısamr	nenfass	ung	93			
Aı	nhang	;		95			
	A. 1	Korrek	ctur von Anschluss-Parasitäten	95			
	A.2	Die Pa	arameter des MEXTRAM-Modells	98			
	A.3	Auftei	lung der MEXTRAM-Parameter bei der Extraktion	100			
	A.4	Gleich	ungen des Kapazitätsmodells	101			
	A.5	Spulen	abibliothek auf dem ATMEL-Prozess	102			
	A.6	Algori	thmus zum Charakterisieren der Leitungen	103			
	A.7	Reduz	ierung der Prozessschritte	105			
	A.8	Prozes	sfluss der Schleifenantennen	106			
	Λ Ω	Drozes	esfluss der Patchantennen	100			

A.10 Versuchsaufbau zum Auslenken der Membranen	111				
A.11 Versuchsaufbau für die Temperaturzyklen	112				
A.12 Fernfeldmessungen an den Schleifenantennen	113				
A.13 Röntgendiffraktometriemessungen an BCB-Membranen	116				
A.14 Doppler Sensoren bei 24 GHz und 32 GHz	117				
Verwendete Formelzeichen					
Literaturverzeichnis					
Veröffentlichungen als Erstautor					
Veröffentlichungen als Koautor	139				
Danksagung	141				
Lebenslauf	142				